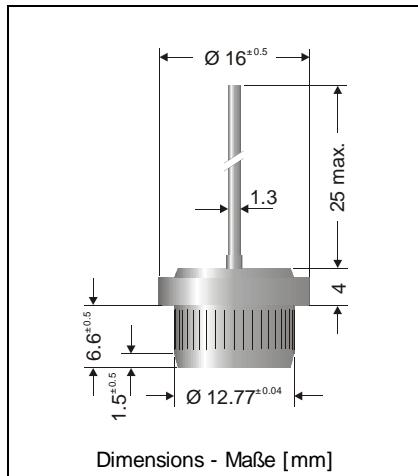


KYW25A05 ... KYW25A6, KYW25K05 ... KYW25K6

Silicon-Press-Fit-Diodes – High Temperature Diodes
Silizium-Einpress-Dioden – Hochtemperatur-Dioden

Version 2006-04-20

Nominal Current
Nennstrom

25 A

Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung

50 ... 600 V

Metal press-fit case with glass seal
Metall-Einpressgehäuse mit Glas-DurchführungWeight approx.
Gewicht ca.

10 g

Compound has classification UL94V-0
Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziertStandard packaging: bulk
Standard Lieferform: lose im Karton**Maximum ratings**

Type / Typ Wire to / Draht an	Anode	Cathode	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	Grenzwerte
KYW25A05	KYW25K05		50	60	
KYW25A1	KYW25K1		100	120	
KYW25A2	KYW25K2		200	240	
KYW25A3	KYW25K3		300	360	
KYW25A4	KYW25K4		400	480	
KYW25A6	KYW25K6		600	700	

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_c = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	25 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	I_{FRM}	90 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_a = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	270/300 A
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_a = 25^\circ\text{C}$	i^2t	375 A ² s
Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_j T_s		-50...+175°C -50...+175°C

¹ Max. case temperature $T_c = 150^\circ\text{C}$ – Max. Gehäusetemperatur $T_c = 150^\circ\text{C}$

Characteristics
Kennwerte

Forward Voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 25 \text{ A}$	V_F	< 1.1 V
Leakage Current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R	< 100 μA
Thermal Resistance Junction – Case Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse		R_{thC}	< 1 K/W

